



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



## Contact us

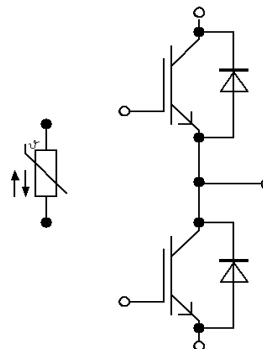
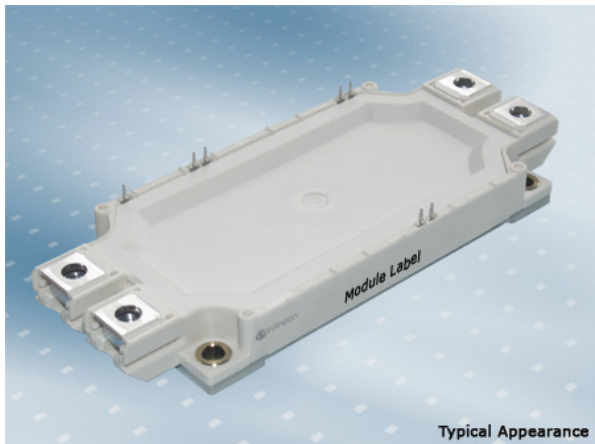
Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



EconoDUAL™3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / NTC  
EconoDUAL™3 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC



$V_{CES} = 1200V$   
 $I_{C\ nom} = 600A / I_{CRM} = 1200A$

**Typische Anwendungen**

- Elektro- und Hybridnutzfahrzeuge
- Hochleistungsumrichter
- Motorantriebe
- Servoumrichter

**Elektrische Eigenschaften**

- Niedriges  $V_{CEsat}$
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- $V_{CEsat}$  mit positivem Temperaturkoeffizienten

**Mechanische Eigenschaften**

- Hohe Last- und thermische Wechselfestigkeit
- Hohe Leistungsdichte
- Isolierte Bodenplatte
- PressFIT Verbindungstechnik

**Typical Applications**

- Construction, Commercial and Agriculture Vehicles
- High Power Converters
- Motor Drives
- Servo Drives

**Electrical Features**

- Low  $V_{CEsat}$
- $T_{vj\ op} = 150^{\circ}C$
- $V_{CEsat}$  with positive Temperature Coefficient

**Mechanical Features**

- High Power and Thermal Cycling Capability
- High Power Density
- Isolated Base Plate
- PressFIT Contact Technology

**Module Label Code**

Barcode Code 128



DMX - Code



**Content of the Code**

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09	
approved by: KV	revision: V3.0	



**IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter**  
**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\text{ max}} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\text{ max}} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ $I_C$	600 950	A A
Grenzeffektivstrom der Modul DC-Kontakte Maximum RMS module DC-terminal current	$T_{\text{Terminal}} \leq 105^{\circ}\text{C}, T_C = 112^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{Terminal}} \leq 105^{\circ}\text{C}, T_C = 139^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{TRMS}}$	415 370	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{\text{CRM}}$	1200	A
Gesamt-Verlustleistung Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\text{ max}} = 175^{\circ}\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	3350	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 600\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 600\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 600\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,75 2,00 2,05	2,10	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 23,0\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{G\text{Eth}}$	5,20	5,80	6,40 V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		$Q_G$	4,40		$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{G\text{int}}$	1,2		$\Omega$
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{\text{ies}}$	37,0		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{\text{res}}$	2,05		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{\text{CES}}$		3,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{\text{GES}}$		400	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 600\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{on}} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$	0,15 0,17 0,17		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 600\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{on}} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,05 0,06 0,06		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 600\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$	0,38 0,47 0,50		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 600\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,07 0,11 0,12		$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 600\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 35\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 8700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{G\text{on}} = 0,51\ \Omega, V_{\text{clamp, GE}} = 18\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{\text{on}}$	18,0 40,5 48,5		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 600\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 35\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, du/dt = 3300\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{G\text{off}} = 0,51\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{\text{off}}$	45,0 70,0 78,0		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{\text{CEmax}} = V_{\text{CES}} - L_{\text{SCE}} \cdot di/dt$ $t_p \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		$I_{\text{SC}}$	2700		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		$R_{\text{thJC}}$		0,0450	K/W

prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$R_{\text{thCH}}$		0,0340		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

**Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter**

**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	$V_{\text{RRM}}$		1200		V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		$I_{\text{F}}$		600		A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_{\text{p}} = 1 \text{ ms}$	$I_{\text{FRM}}$		1200		A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_{\text{R}} = 0 \text{ V}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $V_{\text{R}} = 0 \text{ V}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}, T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$I^2t$		35000 30500		A <sup>2</sup> s A <sup>2</sup> s

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_{\text{F}} = 600 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 600 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 600 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$V_{\text{F}}$	1,90 1,85 1,80	2,30	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_{\text{F}} = 600 \text{ A}, -di_{\text{F}}/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C})$ $V_{\text{R}} = 600 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$I_{\text{RM}}$	495 615 640		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_{\text{F}} = 600 \text{ A}, -di_{\text{F}}/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C})$ $V_{\text{R}} = 600 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$Q_{\text{r}}$	53,0 100 120		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_{\text{F}} = 600 \text{ A}, -di_{\text{F}}/dt = 8700 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C})$ $V_{\text{R}} = 600 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$E_{\text{rec}}$	29,5 52,5 59,5		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		$R_{\text{thJC}}$		0,0870	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		$R_{\text{thCH}}$	0,0400		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{\text{vj op}}$	-40	150	°C

**NTC-Widerstand / NTC-Thermistor**

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	$T_{\text{C}} = 25^\circ\text{C}$		$R_{25}$	5,00		k $\Omega$
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{\text{C}} = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$		$\Delta R/R$	-5	5	%
Verlustleistung Power dissipation	$T_{\text{C}} = 25^\circ\text{C}$		$P_{25}$		20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/50}$	3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/80}$	3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		$B_{25/100}$	3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.  
Specification according to the valid application note.

prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



**Modul / Module**

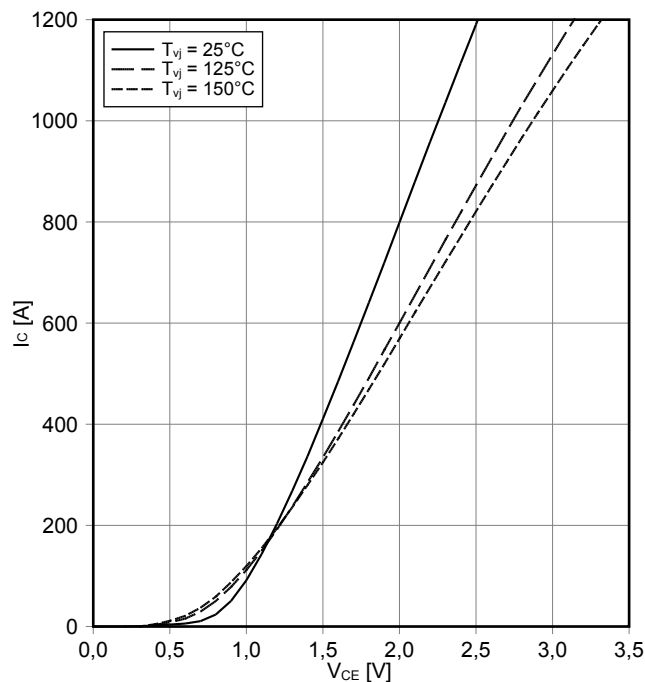
Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V <sub>ISOL</sub>	2,5		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		14,5 13,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		12,5 10,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200		
			min.	typ.	max.
Modulstreuintduktivität Stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		22	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T <sub>C</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>CC'+EE'</sub>		1,00	mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,0	-	6,0 Nm
Gewicht Weight		G		345	g

prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



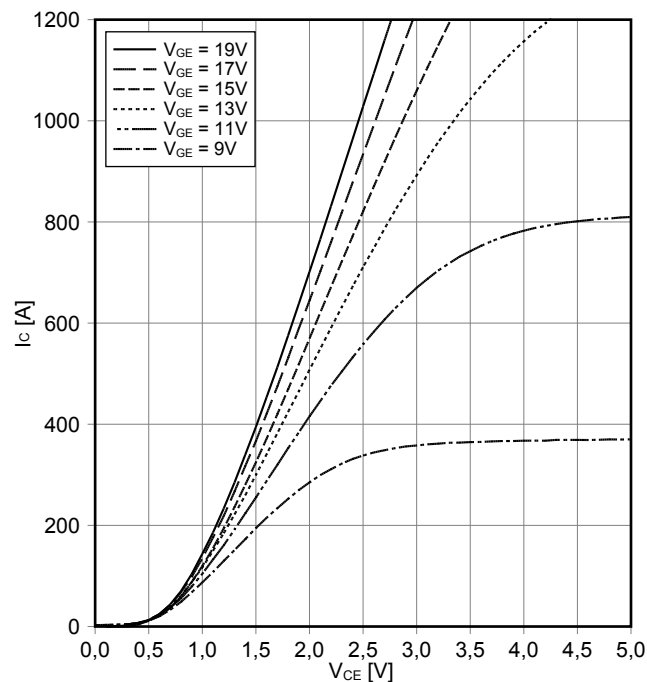
**Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**output characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



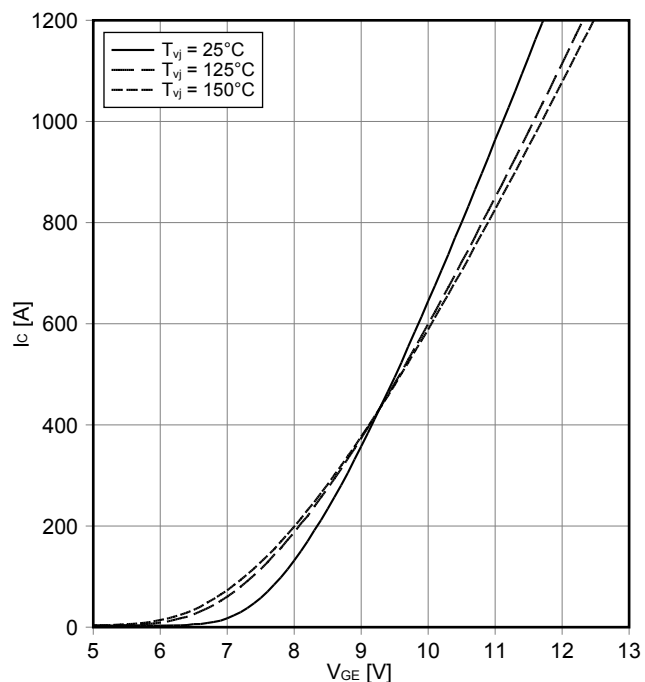
**Ausgangskennlinienfeld IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**output characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



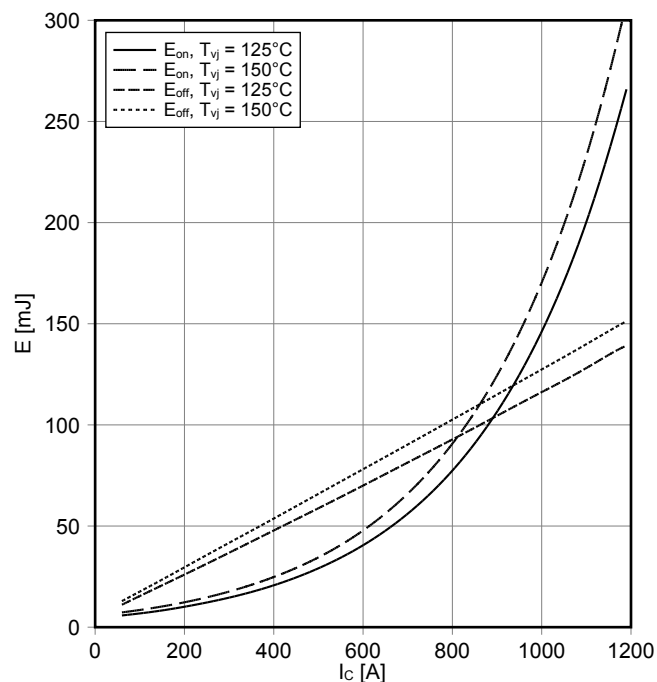
**Übertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



**Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses IGBT, Inverter (typical)**

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.51\ \Omega, R_{Goff} = 0.51\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}$

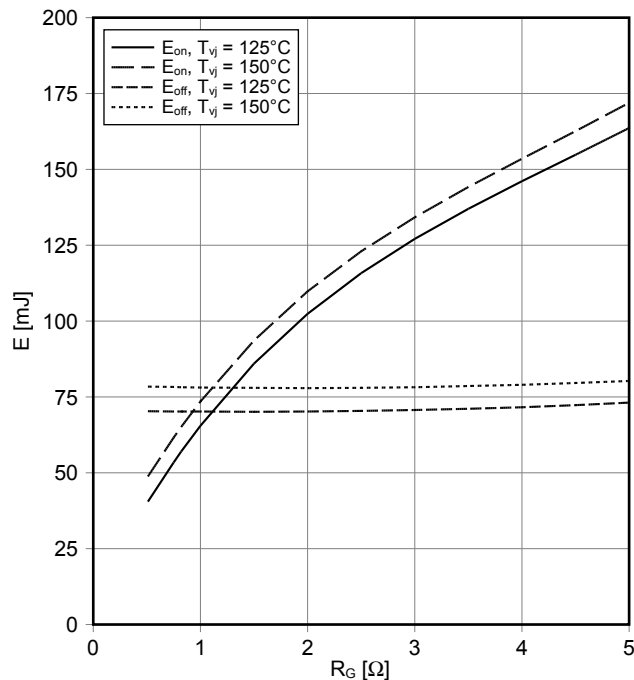


prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



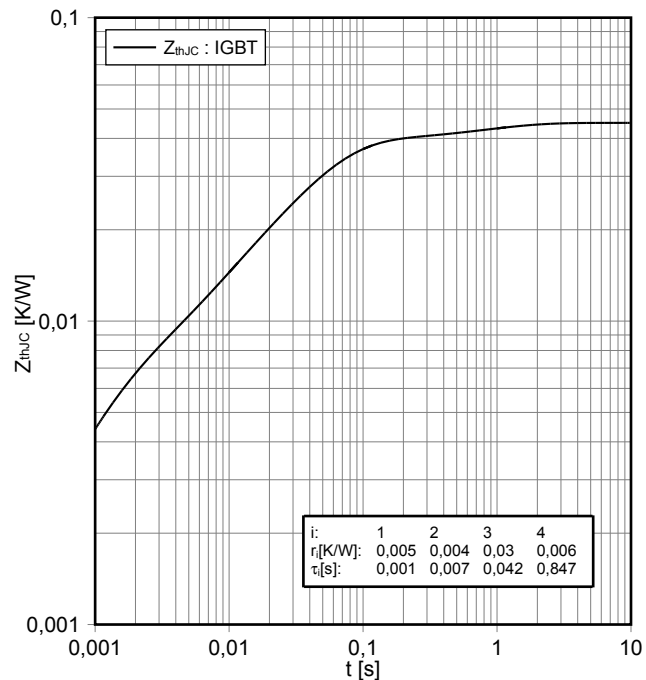
**Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses IGBT, Inverter (typical)**

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 600\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600\text{ V}$



**Transienter Wärmewiderstand IGBT, Wechselrichter**  
**transient thermal impedance IGBT, Inverter**

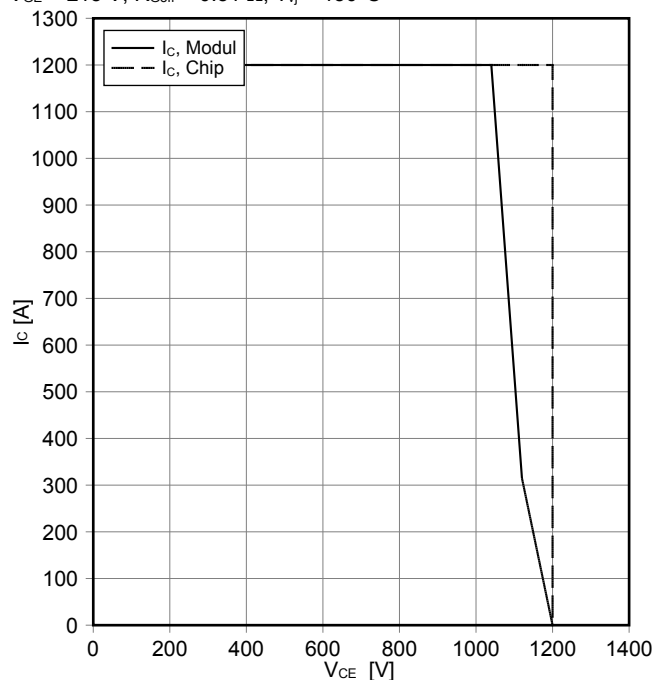
$Z_{thJC} = f(t)$



**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter**  
**(RBSOA)**

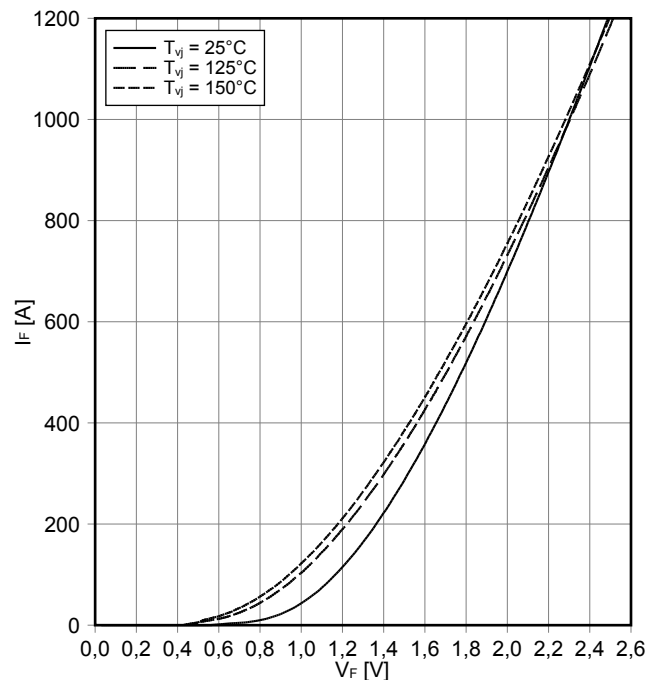
**reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 0.51\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



**Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)**  
**forward characteristic of Diode, Inverter (typical)**

$I_F = f(V_F)$

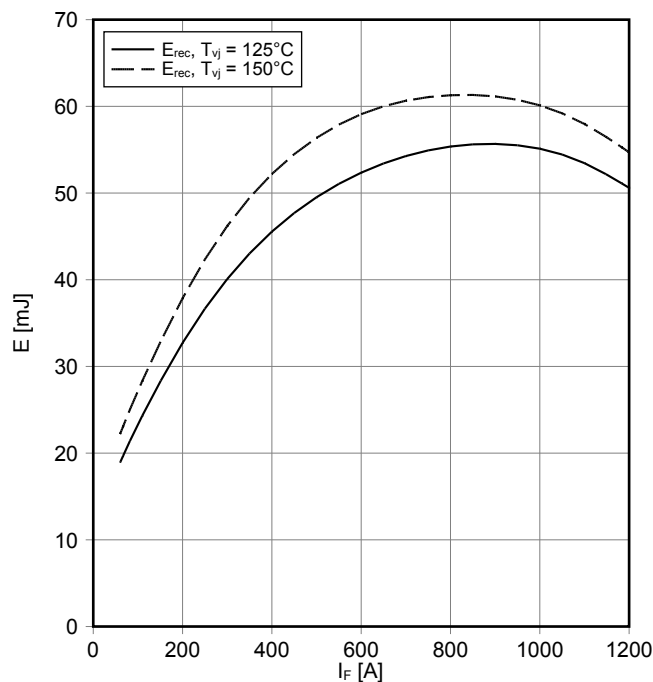


prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



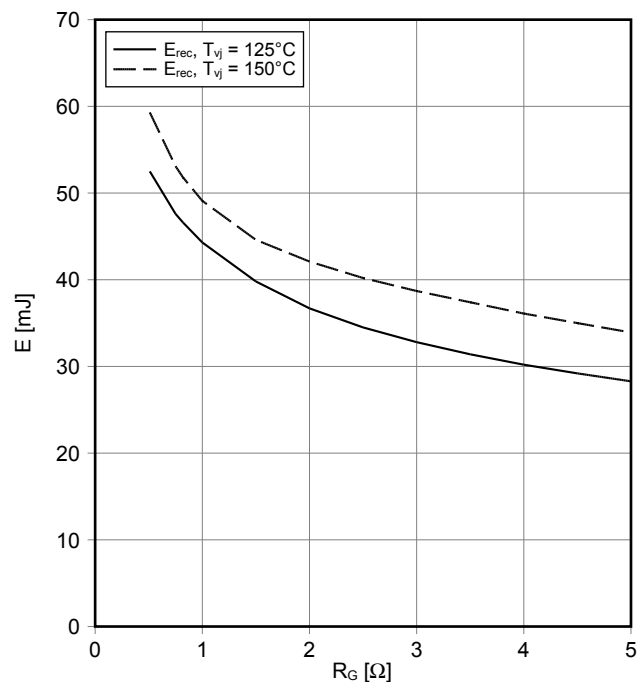
**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses Diode, Inverter (typical)**

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 0.51 \Omega, V_{CE} = 600 V$



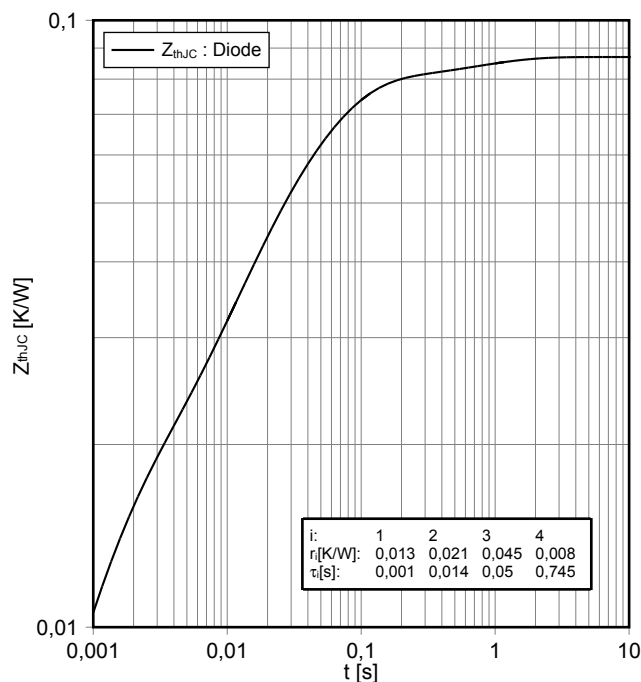
**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses Diode, Inverter (typical)**

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 600 A, V_{CE} = 600 V$



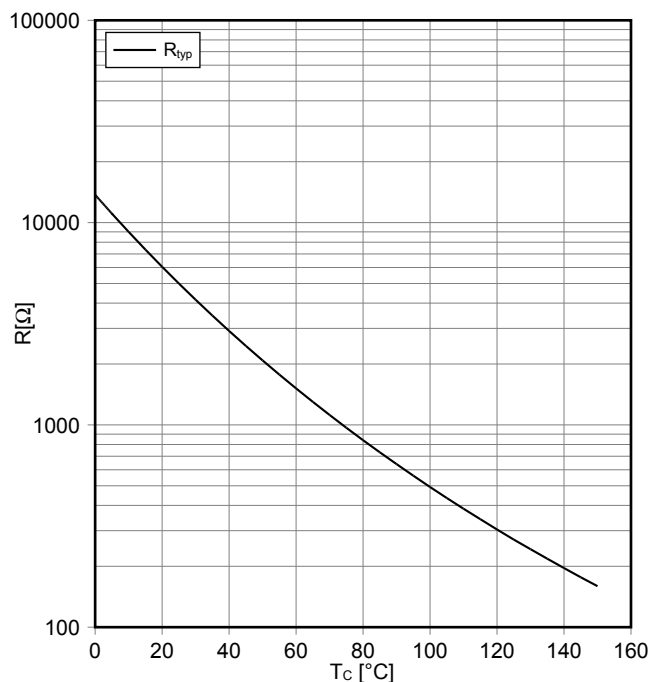
**Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter**  
**transient thermal impedance Diode, Inverter**

$Z_{thJC} = f(t)$



**NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)**  
**NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)**

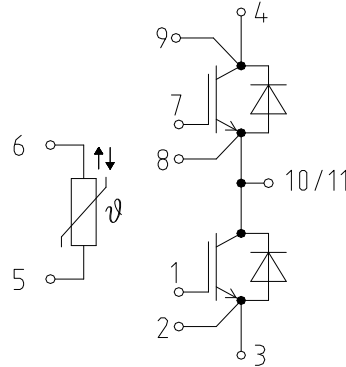
$R = f(T)$



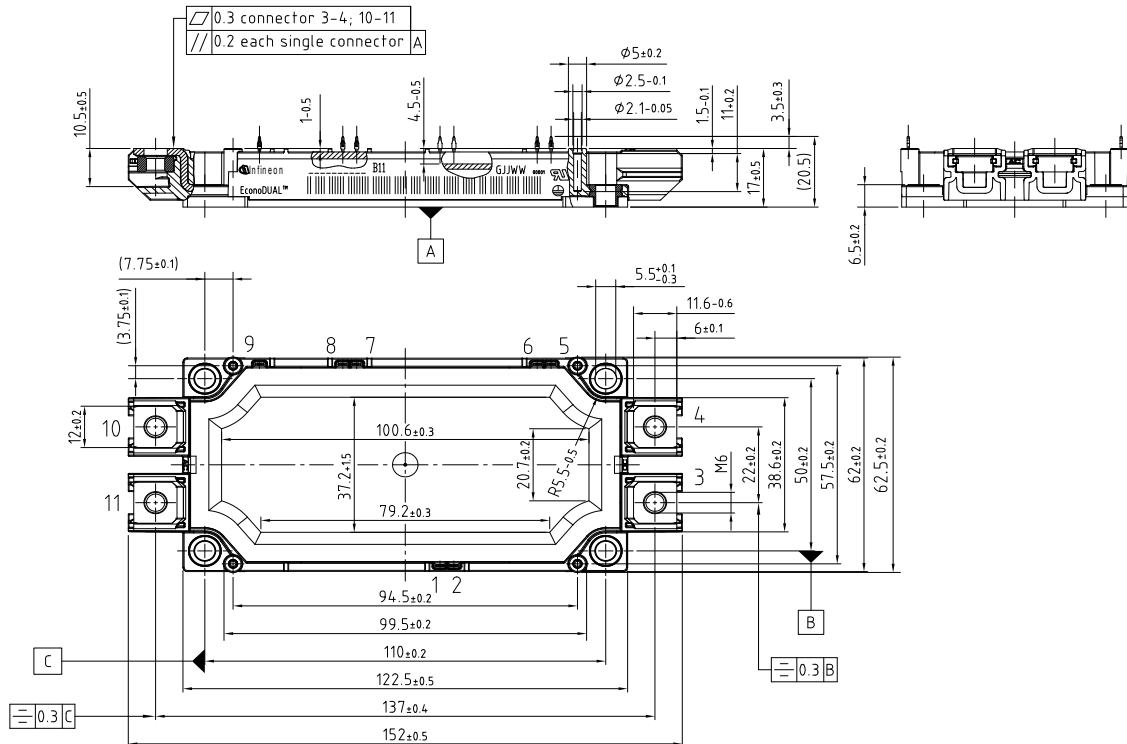
prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



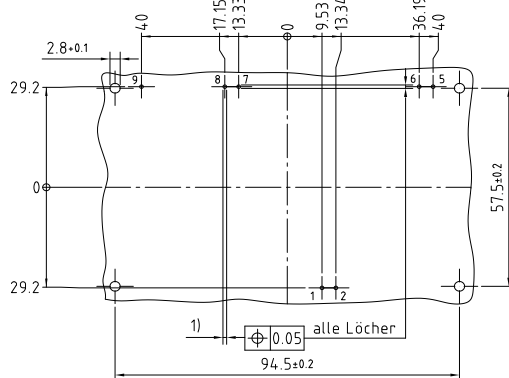
Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern



- 1)  $\phi 1.0_{-0.06}^{+0.09}$  Durchmesser des metallierten Loches
- $\phi 1.0_{-0.06}^{+0.09}$  Diameter of finished plated-through hole
- $\phi 1.15$  Bohrungsdurchmesser des Loches
- $\phi 1.15$  Diameter of drilled hole

prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0



**Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

**Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see [www.infineon.com](http://www.infineon.com) ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: KY	date of publication: 2015-09-09
approved by: KV	revision: V3.0